

～弊社の主な製品の一覧表です。各種ウェハ径、膜種、膜厚に対応いたします。～

下記一覧表に記載が無いものでも、お客様のご要望に応じたウェハを提供しております。  
お気軽にお問い合わせください。

- ベア Si ウェハ(100mm,150mm,200mm,300mm)
- 各種ブランケットウェハ(100mm,150mm,200mm,300mm)  
-Cu, Ta/ TaN, W, Ti/ TiN, Al-Cu, SiN, PE-TEOS, HDP,  
HARP oxide, Poly-Si, Th-Ox, ACL, SiC, SiON  
-各種 Low-k, ULK, High-k - 各種貴金属 Ru, Co, CoEP, Pt, Au
- 半導体樹脂材料-Photo Resist, Polyimide, EMC, PBO, BCB
- 微細トレンチ, ホール ウェハ ●硝子 ウェハ ●シリコンウェハの各種分析も承ります。
- 各種パターンウェハ(100mm,150mm,200mm,300mm)  
-MIT 854/754 パターン ウェハ (W, Mo, Co, Cu, Al),  
-MIT 864/764 STI パターン, ILD パターンウェハ  
-AMT STI パターン ウェハ (min.0.18um LS) -3D パターンウェハ  
-KrF, ArF Litho, 液浸リソと Etched ウェハ  
-High-dose Implanted ウェハ  
-TSV テストウェハ, 低温 TEOS, 低温 SiN ウェハ

アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社 <https://www.amti.co.jp>  
Advanced Materials Technology, Inc.



名 称	アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社
英 語 名 称	Advanced Materials Technology, Inc.
設 立	1997年(平成9年)8月6日
会 社 口 ゴ	<i>AMT</i>
資 本 金	1,000万円
代 表 者	代表取締役会長 西本 豊樹 代表取締役社長 森木 泰次
社 員	21名
本 社 所 在 地	〒811-3114 福岡県古賀市舞の里5丁目39番6号 TEL:092-943-7863 FAX:092-943-7812
福 岡 営 業 所 所 在 地	〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目16番13号 上ノ橋ビル504号室 TEL:092-720-3681 FAX:092-720-3682 E-Mail: morikiy@amti.co.jp
物 流 倉 庫 所 在 地	〒813-0034 福岡市東区多の津1丁目10番6号 フォーサイト第2ビル1F TEL:092-624-6773 FAX:092-624-6774
つ づ ば 事 務 所 所 在 地	〒300-3257 茨城県つくば市筑穂2丁目9番4号 UNITE SOEMO 101号室 TEL:029-864-5801 FAX:029-864-5802
韓 国 事 務 所 所 在 地	16226 大韓民国京畿道水原市霊通区大学4路17 エースタワー I 315-17号室 TEL:+82-10-9130-7503
台 湾 分 公 司	302 中華民國台灣新竹縣竹北市高鐵七路65號13樓之9 TEL:+886-3-668-4975 FAX:+886-3-668-4976

AMT AMERICA, INC.

代 表 者	築瀬 充
本 社 所 在 地	Silicon Valley, California, U.S.A. TEL: +1 (650) 814-8453 E-Mail : mitch@amti.co.jp

## アドバンスマテリアルズテクノロジー株式会社 テストウェハー製品カタログ

*High Quality Test Wafer Supplier*

The customer is our priority  
—we are always on your side

*Advanced Materials Technology, Inc.*

### AMT 180nm STI Pattern Wafer

HDP Oxide complete filling into STI trenches

Center (0.18/0.18um)

Edge (0.18/0.18um)

AMT Proprietary

### AMT 180nm SiN-on-Poly Pattern Wafer

LP-SiN complete filling into Poly trenches

Center (0.18/0.18um)

Edge (0.18/0.18um)

AMT Proprietary

### AMT Custom BUMP Pattern Wafer

Example Pitch 70/90/150um

50um

50um

Si

SnAg

Ni

Cu

Ti

カスタムMASKを用いたパターンウェハ製作が可能です。  
 ・レジストパターン付きウェハ  
 ・Cuピラー形成など

AMT Proprietary

### AMT 180nm W-CVD Pattern Wafer

Mass production technology of TiN/W-CVD fill

Center (180nm)

Center (250nm)

AMT Proprietary

### AMT 180nm ECu Pattern Wafer

Mass production technology of ECu fill

Center (180nm)

AMT Proprietary

### AMT 180nm Mo-PVD Pattern Wafer

Mo complete filling into TEOS trenches

0.18/0.18um

0.25/0.25um

AMT Proprietary

### AMT 3D ILD Pattern Wafer

Large Pattern (10um/3um)

Dense Pattern (10um/10um)

AMT Proprietary

### AMT TSV Pattern Wafer - Process Steps

Top Field TEOS 550nm Via Middle

Top Field Ta 80nm Via Middle

Top Field Ta 2um or 2um Via Middle

Corner Bottom Coverage >90%

Corner Bottom Coverage >10%

Corner Bottom Coverage >91%

SACVD oxide liner fill

Ta barrier fill

Cu seed fill

Cu electro-plating

AMT Proprietary

### AMT Fine Trench Pattern Wafer

Center (60/60nm)

Edge (60/60nm)

Center (60/60nm)

Edge (60/60nm)

AMT Proprietary